

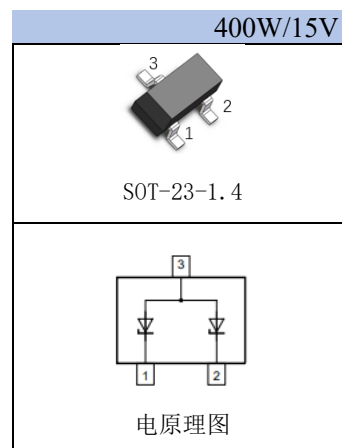
ZL10D40S4P 型瞬态电压抑制二极管阵列

1 特性

- 芯片采用外延平面结构；
- 低电容，响应时间快，双通道；
- 重量（mg）：9.4±1；
- 潮湿敏感度等级：3 级。

2 质量等级及执行标准

G 级：QZJ840611、Q/RBJ1016QZ	G+：Q/RBJ1016QZ、Q/RBJ-GL-02JS-04A
J 级：Q/RBJ-GL-02JS-01A	



3 最大额定值

单芯最大额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

参数	P_{PPM} $t_p=8/20 \mu\text{s}$ W	I_{PP} $t_p=8/20 \mu\text{s}$ A	V_{RWM} V	T_{OP} $^{\circ}\text{C}$	T_j $^{\circ}\text{C}$	T_{stg} $^{\circ}\text{C}$
产品型号						
ZL10D40S4P	400	10	15	-55~125	-55~150	-55~150

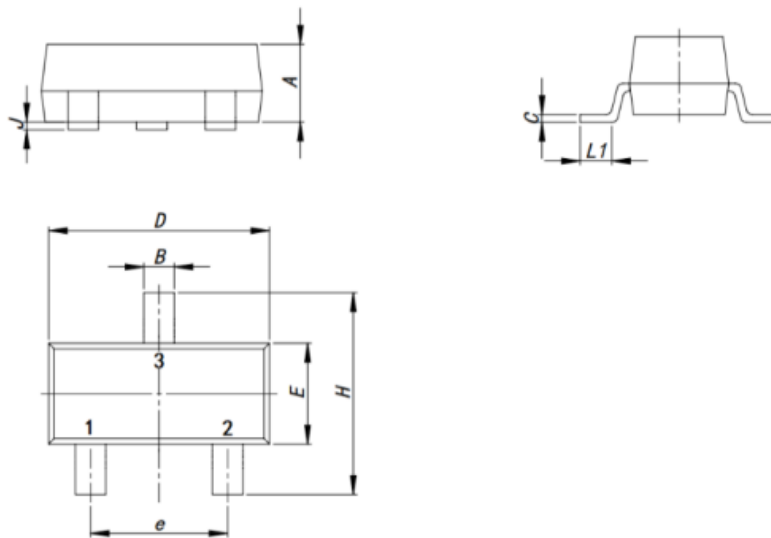
4 主要电特性

单芯主要电特性（除非另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ ）见表 2。

表 2 主要电特性

序号	参数符号	测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
1	V_{BR}	$I_{\text{R}}=1\text{mA}$	16.7	—	20	V
2	V_{C1}	$I_{\text{PP}}=10\text{A}$, $t_p=8/20 \mu\text{s}$	—	—	40	V
3	I_{R}	$V_{\text{R}}=15\text{V}$	—	—	1.0	μA
4	C_j	$V_{\text{R}}=0$, $f=1\text{MHz}$	—	75	150	pF

5 外观尺寸



单位:mm

符号 尺寸	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>e</i>	<i>J</i>	<i>H</i>	<i>L1</i>
最小值	0.79	0.30	0.05	2.70	1.07	1.70	—	2.22	0.16
最大值	1.19	0.50	0.25	3.10	1.47	2.10	0.184	2.62	0.36

图 1 SOT-23-1.4 外形尺寸